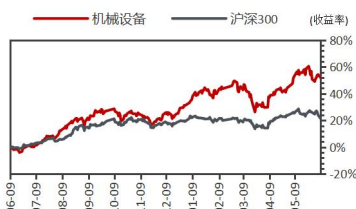


行业及产业

机械设备

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

- 《PCB 设备行业点评：光模块 PCB 扩产潮起，PCB 设备持续景气》2026-07-06
- 《PCB 设备行业点评：TGV 玻璃基板产业化提速，设备环节率先受益》2026-06-29
- 《光通信设备行业点评：CPO 规模化量产渐近，持续看好光通信测试环节》2026-06-22
- 《半导体设备行业点评：SK 海力士以钼代钨，设备链如何传导？》2026-06-15
- 《PCB 设备行业点评：面板级封装与 mSAP 产业化提速，设备率先受益》2026-06-08

证券分析师

王凯
S0820524120002
021-32229888-25522
wangkai526@ajzq.com

存储原厂 Capex 上调，看好半导体设备景气

——半导体设备行业点评

投资要点：

- **事件：**7 月 9 日，美光宣布其在 2035 年前超 2500 亿美元投资计划（较此前 2000 亿美元上调），目标将约 40% DRAM 产能布局美国本土。6 月 29 日，韩国政府联合三星、SK 集团发布总规模 4755 万亿韩元国内投资计划，重点布局半导体及 AI 数据中心。全球存储原厂资本开支持续上修，我们看好海内外半导体设备景气共振。
- **AI 爆发引发 HBM 及大容量存储需求激增，驱动全球存储厂商从“传统数量扩张”转向“以 TSV、混合键合等先进封装/制程为核心的结构性扩产”，直接推高全球资本开支中枢。**
 - 1)全球产能布局：**根据 Yole，2024 年全球 DRAM 与 NAND 合计月产能约 320 万片（按晶圆厂所在地统计），韩国、中国大陆、中国台湾分别占约 45%、24%、16%，全球存储制造仍高度集中于东亚，美国本土产能占比不足 2%。**中国大陆正成为全球存储产能扩张的重要区域。**根据 SemiAnalysis，随着长鑫存储合肥基地全面投产及上海基地一期、二期产能逐步释放，长鑫存储到 2028 年月产能有望提升至 50 万片，对应全球 DRAM 市场份额由 2025 年的 11%提升至约 17%。与此同时，美光宣布 2035 年前累计投资超过 2500 亿美元建设美国本土制造基地，美国存储制造能力亦有望加速提升。
 - 2) 全球存储原厂资本开支进入新一轮上行期。**美光 FY2025 资本开支约 138 亿美元，据 TrendForce 预计，FY2026 将超过 250 亿美元，同比增长超 80%；三星 FY2026 计划总投资（含研发）超过 110 万亿韩元（约 733 亿美元），首次突破 100 万亿韩元，并在业绩说明会上表示 2026 年存储业务资本开支将显著增加；SK 海力士 FY2025 资本开支约 30.2 万亿韩元（约 256 亿美元），FY2026 预计仍将保持大幅增长。
- **我们认为，HBM 对通用 DRAM 产能的持续挤占，有望成为本轮存储景气延续的重要支撑，并进一步推动存储厂商加快产能建设。**

据 TrendForce，三大原厂 HBM 晶圆投入占 DRAM 晶圆总投入的比重将由 2025 年约 18% 升至 2026 年约 22%，2027 年进一步升至约 30%。由于 HBM 单位比特所需晶圆产能约为常规 DDR5 的 2.5 至 3 倍，每增加一片 HBM 产能即挤占数片通用 DRAM 产能，导致通用 DRAM 供给被结构性压缩。存储原厂新增资本开支优先投向 HBM，高端产品产能占比不断提升。在 HBM 产能快速扩张背景下，即使整体 DRAM 晶圆投入保持相对稳定，通用 DRAM 有效供给仍可能低于市场需求增长，从而延长行业景气周期，并进一步推动存储厂商加快先进产能建设。
- **存储层数扩展与 HBM 升级重塑设备价值量分布，沉积、刻蚀及量检测环节深度受益。**

3D NAND 向 300 层以上持续堆叠、HBM 及先进 DRAM 制程不断升级，制造工艺复杂度持续提升，沉积、刻蚀、量检测等关键工艺设备投资强度显著提高。其中，1) 3D NAND 层数增加推动高深宽比刻蚀、介质薄膜沉积等工艺步骤持续增加，带动 ALD、高深宽比刻蚀等设备需求增长；2) HBM 则受益于 TSV、混合键合（Hybrid Bonding）等先进工艺导入，对薄膜沉积、深硅刻蚀、CMP 及量检测设备提出更高要求。3) 同时，工艺复杂度提升带来的良率管理难度持续增加，推动量检测、缺陷检测及过程控制设备需求加速增长。
- **投资建议：AI 驱动全球存储进入新一轮扩产周期，新增产能建设与先进工艺升级同步推进，沉积、刻蚀、量检测等环节设备有望持续受益。推荐【平台型】北方华创(002371)；【沉积】拓荆科技(688072)，微导纳米(688147)；【刻蚀】中微公司(688012)；【量检测】精智达(688627)、精测电子(300567)、天准科技(688003)；【清洗】盛美上海(688082)。**
- **风险提示：**存储芯片需求增长不及预期，全球存储厂商资本开支低于预期，HBM 及先进制程推进不及预期，国产半导体设备验证及导入进度不及预期。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。